

	<h2 style="color: red;">SI4833ADY-T1-E3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI4833ADY-T1-E3</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 30V 4.6A 8-SOIC</p> <hr/> <p>Datenblätter:  SI4833ADY-T1-E3.pdf</p> <hr/> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 39500 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI4833ADY-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 4.6A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	39500 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	LITTLE FOOT®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	72 mOhm @ 3.6A, 10V
Verlustleistung (max)	1.93W (Ta), 2.75W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Andere Namen	SI4833ADY-T1-E3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	750pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	Schottky Diode (Isolated)
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 30V 4.6A (Tc) 1.93W (Ta), 2.75W (Tc)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.6A (Tc)

SI4833ADY-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4833ADY-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4833ADY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI4833ADY-T1-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI4833BDY-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 30V W/S 8-SOIC</p>	 <p>SI4833ADY VIS SI4833ADY VIS</p>	 <p>SI4833DY SILICON SI4833DY SILICON</p>	 <p>SI4833ADY-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 30V 4.6A 8-SOIC</p>
 <p>SI4832DY-T1-E3 VISHAY SI4832DY-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SI4833ADY-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 30V 4.6A 8-SOIC</p>	 <p>SI4833ADY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 4.6A 8-SOIC</p>	 <p>SI4832DY-T1 VISHAY SI4832DY-T1 VISHAY</p>

SI4833ADY-T1-E3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

Electro-Films (EFI) / SI4833ADY-T1-E3 Datenblatt	SI4833ADY-T1-E3-Datenblätter	SI4833ADY-T1-E3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay
Vishay			SI4833ADY-T1-E3
SI4833ADY-T1-E3 Electronic	SI4833ADY-T1-E3-Komponenten	SI4833ADY-T1-E3-Verteiler	SI4833ADY-T1-E3-Bild
SI4833ADY-T1-E3 Preis	SI4833ADY-T1-E3 Hersteller	SI4833ADY-T1-E3 Bild	SI4833ADY-T1-E3 Aktie
SI4833ADY-T1-E3 Neu	SI4833ADY-T1-E3 Original	SI4833ADY-T1-E3 garantiert	SI4833ADY-T1-E3 RFQ
			SI4833ADY-T1-E3 Inventar
			SI4833ADY-T1-E3 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited